

電気学会研究会資料目次

電子デバイス研究会

〔委員長〕 益 一哉 (東京工業大学)

〔副委員長〕 上野和良 (芝浦工業大学)

〔幹 事〕 大見俊一郎 (東京工業大学), 佐藤文彦 (NECエレクトロニクス)

〔幹事補佐〕 本間哲哉 (芝浦工業大学)

日 時 平成20年3月6日(木) 14:00~17:00
3月7日(金) 9:00~12:45

場 所 NTT水上保養所「紫明荘」(群馬県利根郡水上町湯檜曾15-1 JR上越線湯檜曾駅下車, 1~2分または上越線水上駅下車, 谷川ロープウェイ行きバス10分, 湯檜曾駅前下車, 上越新幹線上毛高原駅下車, リレーバスにて水上駅下車(水上駅からは谷川ロープウェイ行きのバスと同様
<http://www.hoyojo.nttkikinkenpo.or.jp/cgi-bin/info/main.cgi?SID=8014>)

テーマ「超高速デバイス・回路技術」

EDD-08-36 AlGaN チャネル HEMT におけるドレイン耐圧の向上

南條拓真, 吹田宗義, 阿部雄次, 大石敏之, 徳田安紀 (三菱電機)

武内道一, 青柳克信 (理化学研究所・東京工業大学) 1

EDD-08-37 サファイア基板へのビアホールを用いた 10400V 耐圧 AlGaN/GaN HFET

上本康裕, 柴田大輔, 柳原 学, 石田秀俊, 松尾尚慶

上田哲三, 田中 毅, 上田大助 (松下電器産業)

永井秀一, Ming Li (パナソニック) 7

EDD-08-38 低温成長 GaN キャップ層を有する AlGaN/GaN HFET

脇 英司, 小野 悟, 出口忠義, 中川 敦 (新日本無線)

寺田 豊, 江川孝志 (名古屋工業大学) 13

EDD-08-39 モンテカルロ計算によるゲート制御ホットエレクトロントランジスタの遮断周波数解析

宮本恭幸 (東京工業大学・JST-CREST)

五十嵐満彦, 山田朋宏, 上澤岳史 (東京工業大学)

古屋一仁 (東京工業大学・JST-CREST) 19

EDD-08-40 ダイヤモンド高周波デバイスの現状と課題

嘉数 誠, 植田研二, 影島博之 (日本電信電話) 25

- EDD-08-41 横方向スケーリングによる InP 系 HEMT の高周波特性向上
 原 直紀, 高橋 剛, 牧山剛三 (富士通)
 多木俊裕 (富士通研究所) …………… 31
- EDD-08-42 トランジスタ領域毎に最適化された複数歪技術を用いる 45nm ノード高性能・低リーク
 バルクロジックプラットフォーム技術
 宮下俊彦, 池田圭司, 金永ソク, 山本知成, 三本杉安弘, 落水洋聡
 迫田恒久, 南方浩志, 早見由香, 島宗洋介, 助川和雄
 筑根敦弘, 池田和人, 杉井寿博 (富士通研究所)
 大越克明, 福田真大, 岡部堅一, 久保智裕, 田島 貢
 山本智彦, 大和田保, 森 年史, 加勢正隆 (富士通) …………… 35
- EDD-08-43 ダマシゲートプロセスを用いた Top-Cut デュアルストレスライナーを有する高性能
 Metal/High-k Gate MOSFETs
 黛 哲, 王 俊利, 山川真弥, 舘下八州志, 平野智之, 中田征志, 山口晋平
 山本雄一, 宮波勇樹, 押山 到, 田中和樹, 田井香織, 小川浩二, 釘宮克尚
 長濱嘉彦, 萩本賢哉, 山本 亮, 神田さおり, 長野 香, 若林 整, 田川幸雄
 塚本雅則, 岩元勇人, 斎藤正樹, 門村新吾, 長島直樹 (ソニー) …………… 41
- EDD-08-44 Ge チャネル MOS トランジスタの課題とサブ 100nm PMOS 動作実証
 山本豊二, 山下良美, 原田正臣, 池田圭司
 鈴木邦広, 杉山直治 (MIRAI-ASET)
 田岡紀之, 木曾 修 (MIRAI-産総研 ASRC)
 高木信一 (MIRAI-産総研 ASRC, 東京大学) …………… 47
- EDD-08-45 新規格化法を用いた工場／製品／水準間比較によるシリコン MOSFET のランダムしきい値
 ばらつき評価
 竹内 潔 (MIRAI-Selete, 日本電気)
 深井利憲, 角村貴昭, 西田彰男, 蒲原史朗 (MIRAI-Selete)
 アリフィン・タムシル・プトラ, 平本俊郎 (東京大学) …………… 53

協 賛 “More Moore, More than Moore” における化合物半導体電子デバイス調査専門委員会